

Физика и техника полупроводников, 2025, том 59, выпуск 3

XXIX Симпозиум " Нанопфизика и нанопэлектроника" , Н. Новгород, 10-14 марта 2025 г.

Капогузов К.Е., Мутилин С.В., Милушин Д.М., Калинина В.Б., Волошин Б.В., Корольков И.В., Кичай В.Н., Яковкина Л.В., Селезнев В.А.

Энергоэффективные и стабильные резистивные переключения в нанокристаллах диоксида ванадия

123

Власов А.С., Аксенов В.Ю., Анкудинов А.В., Берт Н.А., Калюжный Н.А., Павлов Н.В., Пирогов Е.В., Салий Р.А., Сошников И.П., Щенин А.С., Минтаиров А.М.

Сегнетоэлектрические свойства твердых растворов (Al,Ga)InP₂

130

Колесина Д.Е., Кочетков Ф.М., Воробьев А.А., Новикова К.Н., Голтаев А.С., Мухин И.С.

Эластичный светодиод на основе InGaN/GaN-нитевидных микрокристаллов с растяжимыми электродами на основе текстурированных одностенных углеродных нанотрубок и полидиметилсилоксана

136

Неэлектронные свойства полупроводников (атомная структура, диффузия)

Климов Е.А., Виниченко А.Н., Васильевский И.С., Клочков А.Н., Пушкарев С.С., Бурлаков И.Д.

Влияние температуры роста на структурное совершенство пленок CdTe(111), синтезированных методом молекулярно-лучевой эпитаксии на подложках GaAs(100)

141

Иванова А.И., Корнева О.С., Божко И.А., Дектярев С.В., Гурулев А.В.

Влияние плотности энергии высокоинтенсивного пучка ионов титана на накопление и диффузию в кремнии

150

Швец В.А., Марин Д.В., Азаров И.А., Якушев М.В.

Влияние лучистого теплообмена на температуру роста при молекулярно-лучевой эпитаксии слоев HgCdTe

153

Аморфные, стеклообразные, органические полупроводники

Зедоми Т.Э., Котова Л.В., Смирнов А.М., Кочерешко В.П.

Поляризационная спектроскопия тонких пленок полимера F8BT поли(9,9-диоктилфлуорен-альт-бензотиадиазола)

160

Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники

Соболев М.М., Солдатенков Ф.Ю.

Выявление условий формирования глубоких состояний дислокаций несоответствия и DX-центров в гетероэпитаксиальных слаболегированных $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}_{1-y}\text{Sb}_y/\text{GaAs}$ -слоях

165

Физика полупроводниковых приборов

Ризаев А.Э., Подоскин А.А., Шушканов И.В., Капитонов В.А., Шашкин И.С., Вавилова Л.С., Слипченко С.О., Пихтин Н.А.

Оптимизация дизайна гетероструктуры $\text{InGaAsP}/\text{InP}$ мощных лазерных диодов, излучающих на длине волны 1.55 мкм

171

Вербицкая Е.М., Еремин И.В., Фадеева Н.Н., Еремин В.К., Зброжек В.О., Яблоков А.А., Исаков И.Д.

Собирание заряда в кремниевых р+-п-п+-структурах при температуре 40 мК

179